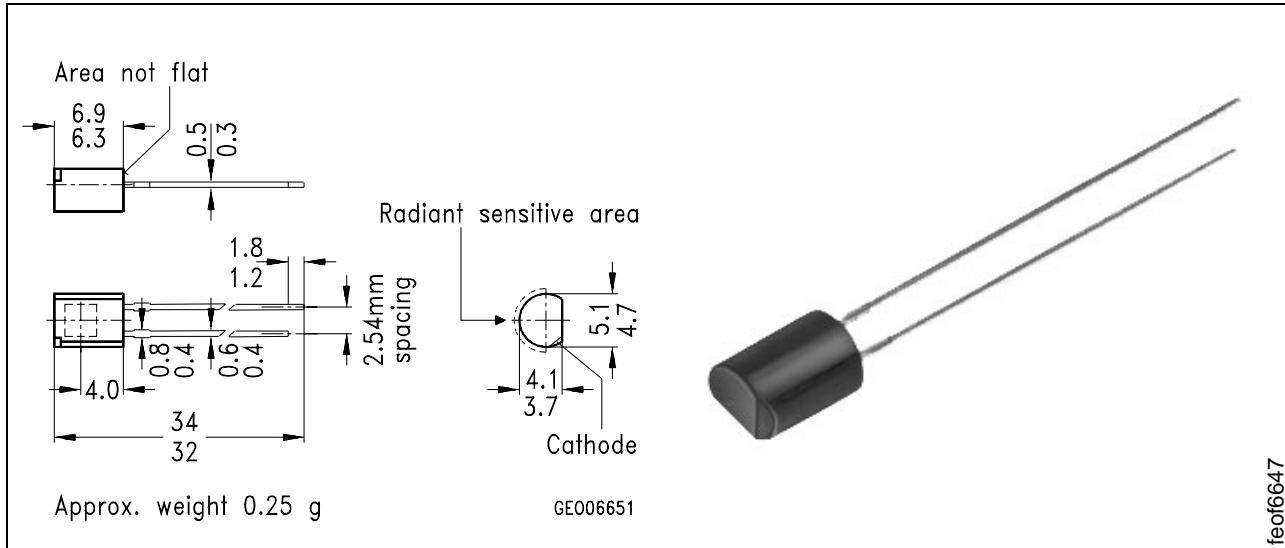


Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter

SFH 205 FA



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 880 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

Features

- Especially suitable for applications of 880 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

Applications

- IR-remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote control of various equipment
- Photointerrupters

| Typ Type | Bestellnummer Ordering Code |
|-------------|--------------------------------|
| SFH 205 FA | Q62702-P1677 |

Grenzwerte**Maximum Ratings**

| Bezeichnung Description | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range | $T_{\text{op}}; T_{\text{stg}}$ | – 55 ... + 100 | °C |
| Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ($t \leq 3$ s) | T_s | 230 | °C |
| Sperrspannung Reverse voltage | V_R | 32 | V |
| Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation | P_{tot} | 150 | mW |

Kennwerte ($T_A = 25$ °C, $\lambda = 870$ nm)**Characteristics**

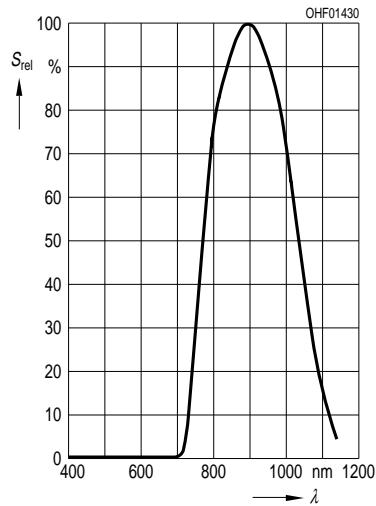
| Bezeichnung Description | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5$ V, $E_e = 1$ mW/cm ² | S | 60 (≥ 45) | µA |
| Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity | $\lambda_{S \text{ max}}$ | 900 | nm |
| Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max} | λ | 740 ... 1100 | nm |
| Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area | A | 7.00 | mm ² |
| Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area | $L \times B$ $L \times W$ | 2.65 × 2.65 | mm × mm |
| Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip surface to case surface | H | 2.3 ... 2.5 | mm |
| Halbwinkel Half angle | ϕ | ± 60 | Grad deg. |
| Dunkelstrom, $V_R = 10$ V Dark current | I_R | 2 (≤ 30) | nA |

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $\lambda = 870 \text{ nm}$)

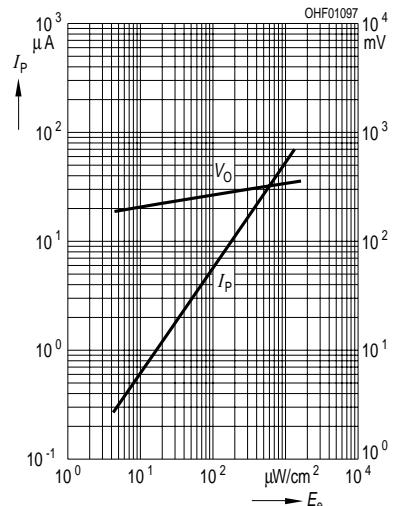
Characteristics (cont'd)

| Bezeichnung Description | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|--|--------------------------|-----------------------|---|
| Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity | S_λ | 0.63 | A/W |
| Quantenausbeute Quantum yield | η | 0.9 | Electrons Photon |
| Leerlaufspannung, $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage | V_O | 350 (≥ 280) | mV |
| Kurzschlußstrom, $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ Short-circuit current | I_{SC} | 56 | μA |
| Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50 \Omega$; $V_R = 5 \text{ V}$; $\lambda = 850 \text{ nm}$; $I_p = 800 \mu\text{A}$ | t_r, t_f | 20 | ns |
| Durchlaßspannung, $I_F = 100 \text{ mA}$, $E = 0$ Forward voltage | V_F | 1.3 | V |
| Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance | C_0 | 72 | pF |
| Temperaturkoeffizient von V_O Temperature coefficient of V_O | TC_V | - 2.6 | mV/K |
| Temperaturkoeffizient von I_{SC} Temperature coefficient of I_{SC} | TC_I | 0.03 | %/K |
| Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10 \text{ V}$ | NEP | 4.0×10^{-14} | $\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ |
| Nachweisgrenze, $V_R = 10 \text{ V}$ Detection limit | D^* | 6.6×10^{12} | $\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$ |

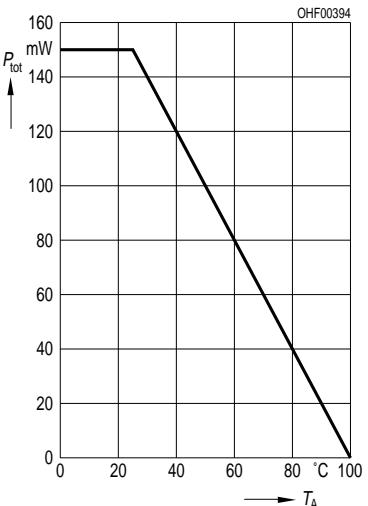
Relative spectral sensitivity
 $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$



Photocurrent $I_P = f(E_e)$, $V_R = 5 \text{ V}$
Open-circuit voltage $V_O = f(E_e)$

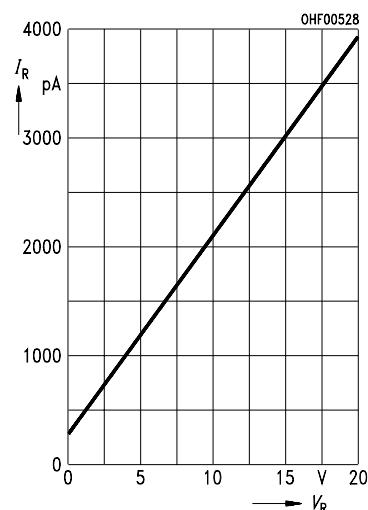


Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_A)$



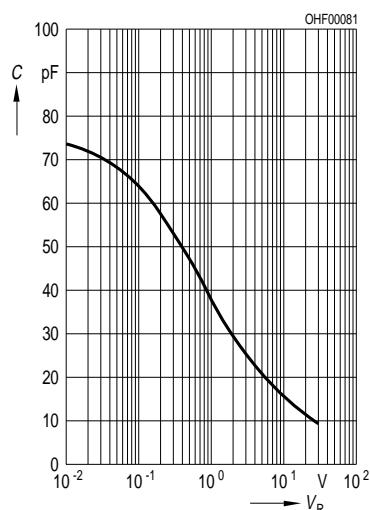
Dark current

$I_R = f(V_R), E = 0$



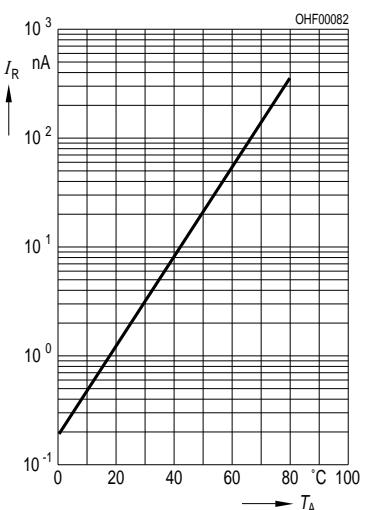
Capacitance

$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



Dark current

$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$



Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\phi)$

